

IMAGE SENSOR AND ITS MANUFACTURE

Patent number:

JP2000196053

Publication date:

2000-07-14

Inventor:

LEE JU IL; KO CHUKO

Applicant:

HYUNDAI ELECTRONICS IND

Classification:

- international:

H01L27/14; G02B3/00; G02B5/20; H01L31/0232

- european:

Application number:

JP19990364287 19991222

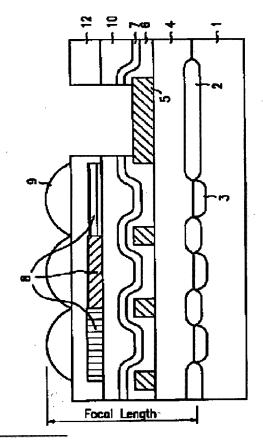
Priority number(s):

KR19980057320 19981222

Report a data error here

Abstract of JP2000196053

PROBLEM TO BE SOLVED: To materialize manufacturing of an image sensor, which improve the reliability in manufacturing. SOLUTION: This manufacturing includes a first step of forming protective films 6 and 7 on a substrate 1 where a light-receiving element is made, a second step of applying the first resist for flattening on the protective films 6 and 7 and exposing and developing the first photoresist 10, so that the protective films 6 and 7 are exposed, a third step of forming a color filter array 8 on the first photoresist 10, a fourth step of applying a second photoresist 12 for flattening on the substrate, where the third step is completed and exposing and developing the protective films 6 and 7 so that the protective films 6 and 7 in a pad open region are exposed, a fifth step of forming a pad open part by etching the exposed protective films 6 and 7, and a sixth step of forming a microlens 9 on the second photoresist 12.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

BEST AVAILABLE COPY

I HIS PAGE BLAINK (USPTO)

· (19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2000-196053 (P2000-196053A)

(43)公開日 平成12年7月14日(2000.7.14)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FI	テーマコード(参考)
H01L	27/14		H01L 27/14	D
G 0 2 B	3/00	•	G 0 2 B 3/00	Z
	5/20	101	5/20	101
H 0 1 L	31/0232		H 0 1 L 31/02	D

審査請求 未請求 請求項の数9 OL (全 6 頁)

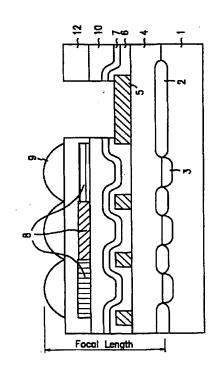
		審查韻求	未請求 請求項の数9 〇L (全 6 頁)
(21)出願番号	特願平11-364287	(71)出願人	591024111 現代電子産業株式会社
(22)出顧日	平成11年12月22日(1999.12.22)		大韓民国京畿道利川市夫鉢邑牙美里山136
(31)優先権主張番号	1998/P57320	(72)発明者	李 柱 日
(32)優先日	平成10年12月22日(1998, 12, 22)		大韓民国 京畿道 利川市 夫鉢邑 牙美
(33)優先権主張国	韓国(KR)		里 山 136-1
		(72)発明者	黄忠 64
			大韓民国 京畿道 利川市 夫針邑 牙美
			里 山 136-1
	•	(74)代理人	100093399
	• .		弁理士 瀬谷 徹 (外1名)

(54) 【発明の名称】 イメージセンサ及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】 製造上の信頼性を向上させたイメージセンサ 製造方法を提供する

【解決手段】 受光素子が形成された基板上に保護膜を形成する第1ステップ、上記保護膜上に平坦化第1フォトレジストを塗布して、パッドオープン地域の上記保護膜が露出されるように上記第1フォトレジストを露光及び現像する第2ステップ、上記第1フォトレジスト上にカラーフィルタアレイを形成する第3ステップ、上記第3ステップが完了した基板上に平坦化第2フォトレジストを塗布して、パッドオープン地域の上記保護膜が露出されるように上記第2フォトレジストを露光及び現像する第4ステップ、露出された上記保護膜を蝕刻してパッドオープン部を形成する第5ステップ、上記第2フォトレジスト上にマイクロレンズを形成する第6ステップとを含んでなる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 イメージセンサ製造方法において、

受光素子が形成された基板上に保護膜を形成する第1ス テップと、

1

上記保護膜上に平坦化第1フォトレジストを塗布し、バッドオープン地域の上記保護膜が露出するように上記第1フォトレジストを露光及び現像する第2ステップと、上記第1フォトレジスト上にカラーフィルタアレイを形成する第3ステップと、

上記第3ステップが完了した基板上に平坦化第2フォト 10 レジストを塗布し、パッドオープン地域の上記保護膜が 露出するように上記第2フォトレジストを露光及び現像 する第4ステップと、

露出した上記保護膜を蝕刻してパッドオープン部を形成する第5ステップと、

上記第2フォトレジスト上にマイクロレンズを形成する 第6ステップと、

を含んでなることを特徴とするイメージセンサの製造方法。

【請求項2】 上記保護膜を形成する前に、層間絶縁膜 20 を上記基板上部に形成するステップ及び上記層間絶縁膜 上に金属配線を形成するステップとをさらに含むことを 特徴とする請求項1記載のイメージセンサの製造方法。

【請求項3】 上記第1フォトレジスト及び第2フォトレジストの厚さは上記マイクロレンズを介して入射する入射光が上記受光素子に集められるように設定されるととを特徴とする請求項2記載のイメージセンサの製造方法。

【請求項4】 上記第1フォトレジスト及び第2フォトレジストの厚さは真空または空気の媒体での上記マイクロレンズの焦点距離及び上記マイクロレンズと上記受光素子との間の膜の屈折率をもとに設定されることを特徴とする請求項3記載のイメージセンサの製造方法。

【請求項5】 上記第1及び第2フォトレジストは透明 物質で形成されることを特徴とする請求項2または請求 項3記載のイメージセンサの製造方法。

【請求項6】 複数の受光素子を含む基板と、

上記基板上部に形成された層間絶縁膜と、

上記層間絶縁膜上に形成された金属配線と、

上記層間絶縁膜上に形成されて上記金属配線を覆ってい 40 る保護膜と、

上記保護膜上に形成された平坦化用第1フォトレジストと、

上記第1フォトレジスト上に形成されて上記受光素子に 対応するカラーフィルタアレイと、

上記カラーフィルタアレイ上に形成される平坦化用第2 フォトレジストと、

上記第2フォトレジスト上に形成される複数のマイクロレンズと、

を含んで、

上記金属配線中のある領域はバッドとして使用され、このバッドは上記保護膜、第1フォトレジスト、カラーフィルタ及び第2フォトレジストで構成される膜をバッドオープン領域で蝕刻することにより形成され、ワイヤボンディングを介して上記受光素子を外部と電気的に接触させることを特徴とするイメージセンサ。

【請求項7】 上記第1及び第2フォトレジストの厚さは上記マイクロレンズを介して入射する入射光が上記受光素子に集められるように設定されることを特徴とする請求項6記載のイメージセンサ。

【請求項8】 上記第1及び第2フォトレジストの厚さは、真空または空気の媒体での上記マイクロレンズの焦点距離及び上記マイクロレンズと上記受光素子との間に存在する膜の屈折率をもとに設定されることを特徴とする請求項7記載のイメージセンサ。

【請求項9】 上記第1及び第2フォトレジストは透明物質で形成されることを特徴とする請求項6又は請求項7記載のイメージセンサ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明が属する技術分野】本発明はイメージセンサ(Image sensor)及びその製造方法に関し、特にイメージセンサのカラーフィルタ及びマイクロレンズ製造技術に関するものである。

[0002]

【従来の技術】周知のように、カラーイメージを実現するためのイメージセンサは、外部からの光を受けて光電荷を生成及び蓄積する光感知部分上部にカラーフィルタがアレイされている。カラーフィルタアレイ(CFA:Color Filter Array)は、レッド(Red)、グリーン(Green)及びブルー(Blue)の3種類のカラーで構成されるか、イエロー(Yellow)、マゼンタ(Magenta)及びシアン(Cyan)の3種類のカラーでなされる。

【0003】また、イメージセンサは、光を感知する光感知部分と、感知された光を電気的信号に処理してデータ化するロジック回路部分で構成されているが、光感度を高めるために単位ピクセルにおける光感知部分の面積が占める比率(Fill Factor)を大きくしようとする努力が進められている。しかしながら、根本的にロジック回路部分を除去出来ないため、制限された面積下ではこのような努力には限界がある。したがって、光感度を高めるために光感知部分以外の領域に入射する光の経路を変えて光感知部分に集める集光技術が登場した。このような集光のためのイメージセンサは、カラーフィルタ上にマイクロレンズ(microlens)を形成する方法を使用している。

【0004】図1は従来の技術によって製造されたイメージセンサを概略的に表した断面図として、カラーフィルタ及びマイクロレンズを具体的に示している。

50 【0005】図1を参照して従来の技術にかかるイメー

ジセンサの製造方法を簡単に説明すると、シリコン基板 1上に素子間の電気的な絶縁のためにフィールド絶縁膜 2を形成して受光素子の光感知領域を含む単位ピクセル 3を形成した後、金属層間絶縁膜4を塗布して金属配線 5を形成する。次いで、水分やスクラッチから素子を保 護するために酸化膜6及び窒化膜7を連続的に塗布して 素子保護膜を形成し、ワイヤボンディング(Wire Bondi ng)の際、素子との電気的な接触のために保護膜を触刻 することによって金属配線5の一部が露出するパッドオ ープン部5aを形成する。以後、イメージセンサのカラ ーイメージの実現のためにカラーフィルタアレイ8を形 成する。カラーフィルタ物質は、通常染色されたフォト レジストを使用する。カラーフィルタアレイの形成後に マイクロレンズ9をカラーフィルタアレイ上に形成す る。このマイクロレンズ9は光感知部分以外の領域に入 射する光を集めるためのものである。

【0006】ところが、この際、保護膜6、7の段差に より単位ピクセル3上でカラーフィルタアレイの厚さが 厚くなり、これを通過する光の光透過度(Light Transm ittance) が低下して、やはりパッドオープン部5aの 金属配線5にはカラーフィルタ物質の残留物8aが残る 現象が発生し、以後、パッケージの際、ワイヤボンディ ング不良の原因となる。また、光感知領域以外の地域に 入射する光を集めるためにマイクロレンズ9を形成する ことになるが、このような工程でも、下に位置している カラーフィルタアレイ8の平坦度が不良であるため、そ の上に形成されるマイクロレンズ9が単位ピクセルごと にその模様が異なり、その特性の均一性(Uniformity) が低下する。

【0007】一方、図から分かるように単位ピクセル3 上の金属層間絶縁膜4、保護膜6、7、カラーフィルタ アレイ8等の厚さでは、その厚さが充分ではないため、 入射する光が、単位ピクセル3の受光素子に正確に集光 しない問題が発生する。すなわち、マイクロレンズと受 光素子との間の距離がマイクロレンズの焦点距離(Foca l Length) より短いため、光感度 (Light Sensitivit y) が低下する現象が発生する。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】本発明は前述したよう な保護膜段差によりカラーフィルタが厚くなる現象、カ ラーフィルタアレイ形成工程後パッド上にカラーフィル タ物質の残留物が残る現象、カラーフィルタパターン段 差によるマイクロレンズのゆがみ現象、及びマイクロレ ンズと受光素子との間の距離がマイクロレンズの焦点距 離より短いことによる光感度低下等の問題を解決し、そ の信頼性が改善されたイメージセンサの製造方法を提供 することにその目的がある。

[0009]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため の本発明のイメージセンサの製造方法は、受光素子が形 50 を形成して受光素子を含む単位ピクセル3を形成した

成された基板上に保護膜を形成する第1ステップと、上 記保護膜上に平坦化第1フォトレジストを塗布し、パッ ドオープン地域の上記保護膜が露出するように上記第1 フォトレジストを露光及び現像する第2ステップと、上 記第1フォトレジスト上にカラーフィルタアレイを形成 する第3ステップと、上記第3ステップが完了した基板 上に平坦化第2フォトレジストを塗布して、パッドオー プン地域の上記保護膜が露出するように上記第2フォト レジストを露光及び現像する第4ステップと、露出され 10 た上記保護膜を触刻してバッドオープン部を形成する第 5ステップと、上記第2フォトレジスト上にマイクロレ ンズを形成する第6ステップとを含んでなる。

【0010】また、本発明の目的を達成するための本発 明のイメージセンサは、複数の受光素子を含む基板と、 上記基板上部に形成された層間絶縁膜と、上記層間絶縁 膜上に形成された金属配線と、上記層間絶縁膜上に形成 されて上記金属配線を覆っている保護膜と、上記保護膜 上に形成された平坦化用第1フォトレジストと、上記第 1フォトレジスト上に形成されて上記受光素子に対応す 20 るカラーフィルタアレイと、上記カラーフィルタアレイ 上に形成される平坦化用第2フォトレジストと、上記第 2フォトレジスト上に形成される複数のマイクロレンズ とを含んで、上記金属配線中のある領域はバッドとして 使われて、このパッドは上記保護膜と、第1フォトレジ ストと、カラーフィルタ及び第2フォトレジストとで構 成される膜をバッドオープン領域で蝕刻することにより 形成されてワイヤボンディングを介して上記受光素子を 外部と電気的に接触させるものである。

【0011】好ましくは、上記第1フォトレジスト及び 第2フォトレジストの厚さは、マイクロレンズを介して 入射する入射光が受光素子に集められるように設定さ れ、好ましくは、真空または空気のような周知の媒体 で、マイクロレンズの焦点距離及びマイクロレンズと受 光素子との間に存在する膜の屈折率をもとに設定され る。また、上記第1及び第2フォトレジストは透明物質 で形成するほうが好ましい。

[0012]

【発明の実施の形態】以下、本発明が属する技術分野で 通常の知識を有する者が本発明の技術的思想を容易に実 施できる程度に詳細に説明するために、本発明の最も好 ましい実施例を、添付した図面を参照し説明する。従来 の技術と同一の構成要素に対しては同一の図面符号を附 した。

【0013】図2ないし図6は本発明の一実施例にかか るイメージセンサ製造工程を示す断面図であり、カラー フィルタ及びマイクロレンズにその重点をおいてイメー ジセンサが図示されている。

【0014】まず、図2を参照すると、シリコン基板1 上に素子間の電気的な絶縁のためのフィールド絶縁膜2

後、その上部に層間絶縁膜4及び金属配線5を形成す る。以後、水分やスクラッチから素子を保護するために 酸化膜6及び窒化膜7を連続的に塗布して保護膜6、7 を形成する。次いで、平坦化兼パッドオープン用第1フ ォトレジスト10を塗布した後、パッドオープン用マス ク11を使用してバッド部位のフォトレジスト (図面の 10a)を露光及び現像する。ことで使われる平坦化兼 パッドオープン用第1フォトレジスト10は、下部に位 置した受光素子の光感度低下を防止するために可能な限 り光透過度に優れた透明なフォトレジストを使用する。 【0015】次いで、図3を参照すると、以後、バッド 地域の保護膜6、7が露出した状態で平坦化されたフォ トレジスト10上に、イメージセンサのカラーイメージ 実現のために3原色のカラーフィルタアレイ8を形成す る。カラーフィルタアレイ工程は通常の方法と同様であ るが、保護膜6、7の段差は第1フォトレジストにより 相殺されて平坦化されるため、単位ピクセル3上でカラ ーフィルタパターンの厚さは一定であり、これを通過し た光の光透過度が向上することになる。一方、フォトレ ジスト10の段差によりパッド部位の保護膜6、7上に 20 はカラーフィルタ物質の残留物8aが残存する現象が発 生する。

【0016】次いで、図4を参照すると、平坦化兼パッ ドオープン用第2フォトレジスト12を塗布し、パッド オープン用マスク11を再度使用して、バッド部位の第 2フォトレジスト (図面の12a) を露光及び現像す る。この際、このフォトレジスト12は下部に位置した 受光素子の光感度の低下防止のために可能な限り光透過 度に優れた透明なフォトレジストを使用することがよ

【0017】次いで、図5を参照すると、ワイヤボンデ ィング素子との電気的な接触のためのバッドオープン部 を形成するために第1フォトレジスト10及び第2フォ トレジスト12がオープンされた地域で露出されている 保護膜6、7を触刻する。この際、バッド部位の保護膜 6、7上に存在するカラーフィルタ物質の残留物8aは 共に蝕刻されて除去され、これによってバッド金属層表 面に異質物のないきれいなパッドを形成することができ る。

【0018】次いで、図6は光感知領域以外の地域に入 40 射する光を集めるためにマイクロレンズ9を形成すると とによりイメージセンサの製造を完了した状態である。 この際、下に位置しているカラーフィルタパターンは平 坦化用第1フォトレジスト10及び第2フォトレジスト 12によって平坦化され、その上に形成されるマイクロ レンズは単位ピクセルごとにその模様が均一になる。

【0019】一方、図6に示したように単位ピクセル3 上の層間絶縁膜4、保護膜6、7、第1フォトレジスト 10、カラーフィルタパターン8、第2フォトレジスト 12等の厚さは十分に厚く形成され、また、第1及び第 50 10 平坦化第1フォトレジスト

2フォトレジストの厚さを適切に調節してマイクロレン ズと受光素子との間の距離を調節できるために、光感度 を向上させることができる。この際、マイクロレンズと 受光素子との間の距離は、第1及び第2フォトレジスト の厚さの調節によってマイクロレンズに入射する光が受 光素子に正確に集まるように調節できる。これは、真空 または空気のようなよく知らされた媒体でのマイクロレ ンズの焦点距離及びマイクロレンズと受光素子との間の 膜の屈折率をもとに設定することができる。

【0020】以上、本発明の技術思想を上記好ましい実 10 施例によって具体的に記述したが、上記実施例はその説 明のためのものであってその制限のためのものではない ことを注意すべきである。また、本発明の技術分野の通 常の専門家であるならば本発明の技術思想の範囲内で種 々の実施例が可能であることが理解できる。

[0021]

【発明の効果】本発明におけるカラーフィルタ及びマイ クロレンズ製造方法を適用することにより、 カラーフィ ルタパターンの光透過度を向上させることができ、焦点 距離増加による光感度を向上させることができることか ら、製品の競争力を確保することができるようになる。 また、異質物のないバッド表面を形成することができる ことから、パッケージ収率を向上させることができ、さ らに、ゆがみのないマイクロレンズとすることができる ために製品の信頼性が向上する等の優れた効果を奏す る。

【図面の簡単な説明】

【図1】従来の技術によって製造されたイメージセンサ を概略的に示した断面図である。

【図2】本発明の一実施例にかかるイメージセンサ製造 工程を示す断面図である。

【図3】本発明の一実施例にかかるイメージセンサ製造 工程を示す断面図である。

【図4】本発明の一実施例にかかるイメージセンサ製造 工程を示す断面図である。

【図5】本発明の一実施例にかかるイメージセンサ製造 工程を示す断面図である。

【図6】本発明の一実施例にかかるイメージセンサ製造 工程を示す断面図である。

【符号の説明】

- 1 シリコン基板
- 2 フィールド絶縁膜
- 3 単位ピクセル
- 4 層間絶縁膜
- 5 金属配線
- 6、7 保護膜
- 8 カラーフィルタアレイ
- 8 a カラーフィルタ物質の残留物
- 9 マイクロレンズ

(5)

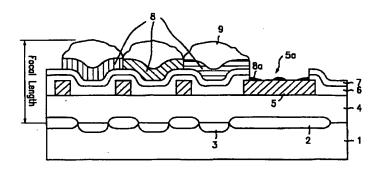
特開2000-196053

8

11 パッドオープン用マスク

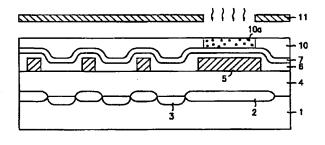
* * 12 平坦化第2フォトレジスト

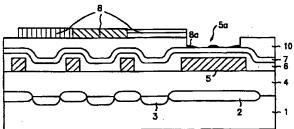
【図1】



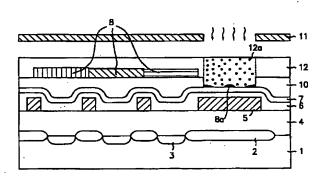
【図2】

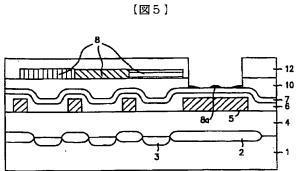
【図3】





【図4】





BEST AVAILABLE COPY

【図6】

